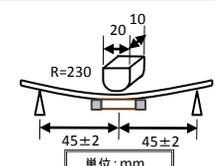


性能及び試験方法

■性能及び試験方法(スタック形積層セラミックコンデンサ)

項目		性能	試験方法および条件 (JIS C 5101-1準拠)									
		R特性										
静電容量		許容差以内	CLASS 2 <table border="1"> <tr> <td>公称静電容量</td> <td>測定周波数</td> <td>測定電圧</td> </tr> <tr> <td>$C \leq 10\mu\text{F}$</td> <td>1kHz\pm10%</td> <td>1.0\pm0.2Vrms</td> </tr> <tr> <td>$C > 10\mu\text{F}$</td> <td>120Hz\pm10%</td> <td>0.5\pm0.2Vrms</td> </tr> </table> 測定前に熱処理を行う。	公称静電容量	測定周波数	測定電圧	$C \leq 10\mu\text{F}$	1kHz \pm 10%	1.0 \pm 0.2Vrms	$C > 10\mu\text{F}$	120Hz \pm 10%	0.5 \pm 0.2Vrms
公称静電容量	測定周波数	測定電圧										
$C \leq 10\mu\text{F}$	1kHz \pm 10%	1.0 \pm 0.2Vrms										
$C > 10\mu\text{F}$	120Hz \pm 10%	0.5 \pm 0.2Vrms										
Qおよび誘電正接		RS: 5.0%以下										
耐電圧		絶縁破壊および破損のないこと 定格電圧 50~100V : 定格電圧の250% 定格電圧 250 : 定格電圧の200% 定格電圧 630V : 定格電圧の150%	印加電圧 : 1~5秒間 シリコンオイル中で印加 (W.V.630V以上) 充放電電流 : 50mA以下									
絶縁抵抗		10,000M Ω または500M Ω ・ μF のいずれか小さい方の値以上	印加電圧 : 定格電圧 (W.V.630V以上は500V) 印加時間 : 1分間									
固着性		端子電極の剥離またはその兆候がないこと	荷重 : 5N 保持時間 : 10秒間									
はんだ付け性(フレーム面に適用)		端子電極面が75%以上新しいはんだで覆われていること	温度: 230 \pm 5 $^{\circ}\text{C}$ 浸漬時間: 2 \pm 1秒									
温度 サイクル	外観	著しい機械的損傷がないこと	常温 \rightarrow 最低使用温度 \rightarrow 常温 \rightarrow 最高使用温度 3分 \rightarrow 30分 \rightarrow 3分 \rightarrow 30分 上記1~4段階の温度に順次放置し1サイクルとする この操作を5サイクル繰り返す									
	静電容量変化率	\pm 7.5%以下										
	Qおよび誘電正接	初期値を満足すること										
	絶縁抵抗	初期値を満足すること										
耐湿負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと	電圧処理を行う。 試験温度: 40 \pm 2 $^{\circ}\text{C}$ 相対湿度: 90~95%RH 試験電圧: 定格電圧 試験時間: 500時間									
	静電容量変化率	\pm 12.5%以下										
	Qおよび誘電正接	初期値の2倍以下										
	絶縁抵抗	1,000M Ω または50M Ω ・ μF のいずれか小さい方の値以上										
高温負荷	外観	著しい機械的損傷がないこと	電圧処理を行う。 試験温度: 最高使用温度 \pm 3 $^{\circ}\text{C}$ 試験電圧: W.V.=250V以下: 定格電圧 \times 200%の直流電圧 W.V.=630V以上: 定格電圧 \times 100%の直流電圧 試験時間: 1000時間 *試験条件は品種ごとに異なります。 詳細は個別の仕様書をご確認ください									
	静電容量変化率	\pm 12.5%以下										
	Qおよび誘電正接	初期値の2倍以下										
	絶縁抵抗	1,000M Ω または50M Ω ・ μF のいずれか小さい方の値以上										
たわみ	外観	著しい機械的損傷がないこと	熱処理を行う。 たわみ量: 1mm 移動速度: 0.5mm/sec 試験中は静電容量計を 接続する 									
	静電容量変化率	\pm 12.5%以下										

注1: 品種により性能仕様が異なります。詳細は個別の仕様書をご確認ください。

注2: 熱処理は150 \pm 0/-10 $^{\circ}\text{C}$ にて1時間後、室温中に取り出し48 \pm 4時間放置する

注4: 電圧処理は試験条件に規定されている条件にて1時間処理後、室温中に取り出し48 \pm 4時間放置する